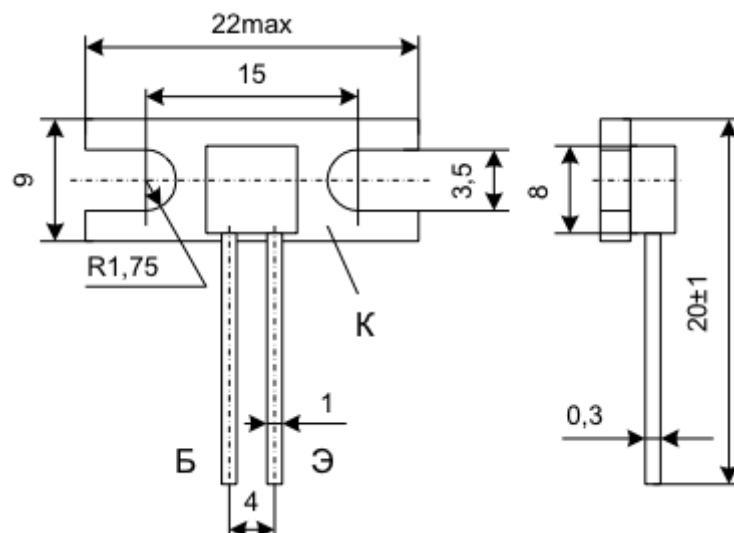




KT807Б

Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры п-р-п универсальные. Предназначены для применения в усилителях постоянного тока, генераторах кадровой и строчной разверток, усилителях низкой частоты, источниках вторичного электропитания. Выпускаются в металлопластмассовом корпусе с гибкими выводами.



Тип прибора указывается на корпусе. Масса транзистора не более 2,5 г.

Технические условия: ГЕ3.365.005 ТУ.

Основные технические характеристики транзистора КТ807Б:

- $h_{21\beta}$ - Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{\text{КЭ}} = 5 \text{ В}$, $I_{\text{К}} = 0,5 \text{ А}$, $t = +25^{\circ}\text{C}$: 30...100;
- $f_{\text{гр}}$ - Границчная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ: не менее 5 мГц;
- $U_{\text{КЭ нас}}$ – Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_{\text{К}} = 0,5 \text{ А}$, $I_{\text{Б}} = 0,1 \text{ А}$: 1 В;
- $I_{\text{КЭо}}$ - Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{\text{БЭ}} = 10 \text{ Ом}$, $U_{\text{КЭ}} = 100 \text{ В}$, $t_{\text{К}} = +25^{\circ}\text{C}$: не более 5 мА;
- $I_{\text{ЭБо}}$ - Обратный ток эмиттера при $U_{\text{ЭБ}} = 4 \text{ В}$: не более 15 мА;
- $U_{\text{КЭ имп max}}$ – Максимальное импульсное напряжение коллектор-эмиттер: 120 В;
- $U_{\text{ЭБо max}}$ – Максимальное постоянное напряжение эмиттер-база: 4 В;
- $I_{\text{К max}}$ - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 0,5 А;
- $P_{\text{К max}}$ - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $t = -40 \dots +70^{\circ}\text{C}$: 10 Вт;
- $t_{\text{П}}$ – Температура р-п перехода: не более $+150^{\circ}\text{C}$;
- $t_{\text{окр}}$ – Температура окружающей среды: $-40 \dots +85^{\circ}\text{C}$.